Eu, Mg 共添加 AlGaN の Al 組成が発光サイトに与える影響

Effect on the emission site of Al composition of Eu and Mg codoped AlGaN

豊橋技術科学大学工学部¹,エレクトロニクス先端融合研究所(EIIRIS)²

°金本匡祥¹, 関口寛人¹, 山根啓輔¹, 岡田浩^{2,1}, 若原昭浩¹

Toyohashi University of Technology¹, Electronics-Inspired Interdisciplinary Research Institute²

M. Kanemoto¹, H. Sekiguchi¹, K. Yamane¹, H. Okada¹, A. Wakahara¹

E-mail: kanemoto-m@int.ee.tut.ac. jp, sekiguchi@ee.tut.ac.jp

Eu 添加窒化物半導体は狭い発光線幅,高い発光波長安定性といった優れた特徴を有し,次世代発光 デバイスへの応用が期待されている.我々は NH₃-MBE 法により Eu 添加 GaN を活性層とした赤色 LED を実現したが,その発光効率は低い[1].そこで,Mg 共添加や母材に AlGaN を用いることで発光効率 の改善に取り組み[3], Eu 添加 AlGaN においても Mg 共添加が発光特性の向上に有効であることを明 らかにしてきた.しかしながら,Mg 共添加した際の発光サイトは GaN と AlGaN では異なっていた. 本研究では,Al 組成が発光サイトに与える影響を明らかにすべく,低温及び室温において PL スペク トルを詳細に評価したので報告する.

NH₃-MBE 法を用いて, GaN テンプレート基板上に Eu, Mg 共添加 AlGaN(AlGaN:Eu,Mg)を成長させた. ここでは Al フラックスを変化させることで,Al 組成を 0%から 27.6%の範囲で制御した。Eu 濃度とMg 濃度はそれぞれ $4x10^{19}$ cm⁻³ と $3x10^{18}$ cm⁻³ と固定とした. Fig. 1 に異なる Al 組成をもつ AlGaN:Eu,Mg の室温 PL スペクトルを示す.主に 620.3nm(サイト A), 622.3nm(サイト B), 634.2nm の3つの発光ピークが観測された. Al 組成の増加に伴い支配的な発光ピークはピーク A からピーク B へと変化した.Fig. 2 に PL 積分強度および低温と室温の PL 積分強度比により定義した PL 効率の Al 組成依存性を示す. 25K では Al 組成の増加に伴い,積分強度は増大し Al 組成 27.6%において約 2 倍となった.低温では非発光成分が十分に抑制されていると考えられるので,活性な発光サイト数が増大していることを示唆している.一方,300K では,Al 組成の増加に伴い PL 積分強度はわずかに減少する傾向を示したが,Al 組成 27.6%において,再び増加し GaN:Eu,Mg とほぼ同程度の強度となった.全体の PL 効率に注目すると,Al 組成の増加に伴い 0.6 から 0.35 へと減少した.ピーク分離することで,ピーク A,ピーク B の PL 効率を評価した.ピーク A の PL 効率は 0.6~0.7 となったのに対して,ピーク B の PL 効率は 0.35 でほぼ一定となった.したがって,Al 組成に伴う PL 効率の低下はピーク A とピーク B の存在比が変化したことに起因すると考えられる.

[1] H. Sekiguchi et al., Jpn. J. Appl. Phys., **52**, 08JH01 (2013). [2] Y. Takagi et al., Appl. Phys. Lett. **99**, 171905 (2011). [3] 金本他, 第 75 回秋季応用物理学術講演会, 20p-c5-5, 北海道, 2014年9月.

【謝辞】本研究の一部は科研費補助金#26420271と公益財団法人豊秋奨学会の援助を受けて行った.



Fig. 1 PL spectra from Eu^{3+} luminescence in (Al)GaN:Eu, Mg with different Al composition



Fig. 2 PL integrated intensity as a function of Al composition (top) and PL efficiency for site A and site B and total (bottom).